

吸収分割に係る事前開示書類

(会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項)

2023 年 2 月 1 日

三菱マテリアル株式会社

2023年2月1日

吸収分割に係る事前開示書類
(会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項)

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
三菱マテリアル株式会社
代表執行役 小野 直樹



三菱マテリアル株式会社(以下「甲」といいます。)及び高純度シリコン株式会社(以下「乙」といいます。)は、2022年12月27日付で吸収分割契約を締結し、効力発生日を2023年3月31日として、甲が営む多結晶シリコン事業に関して有する権利義務(但し、別紙1の吸収分割契約に定める承継対象権利義務に限ります。)を乙に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)を行うことにいたしました。

本吸収分割に関する会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項は、以下のとおりです。

1. 吸収分割契約の内容(会社法第782条第1項第2号)

別紙1に記載のとおりです。

2. 分割対価の相当性に関する事項(会社法施行規則第183条第1号イ)

乙は、本吸収分割に際して、甲に対して、乙の普通株式1株を交付します。乙は甲の100%子会社であるため、交付株式数により両社間の実質的な関係に影響を与えるものではなく、また、交付株式数は両者間の協議により決定したものであり、相当であると判断しております。

また、本吸収分割により乙の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しない旨の定めは、本吸収分割により乙に承継される資産及び負債の額、本吸収分割後の乙の事業内容等を考慮し、相当であると判断しております。

3. 会社法第758条第8号に関する事項(会社法施行規則第183条第2号)

該当事項はありません。

4. 本吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項についての定め相当性に関する事項(会社法施行規則第183条第3号)

該当事項はありません。

5. 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項(会社法施行規則第183条第4号)

(1) 吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表(同号イ)

別紙2に記載のとおりです。

- (2) 吸収分割承継会社の成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（同号ロ）

該当事項はありません。

- (3) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（同号ハ）

該当事項はありません。

6. 吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第183条第5号イ）

別紙3に記載のとおりです。

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会社の債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第183条第6号）

- (1) 甲の債務の履行の見込みについて

甲の2022年3月31日現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ1,573,837百万円及び1,159,820百万円です。

甲において、上記の日時時点から本書面作成日現在に至るまで、上記6で記載した事項以外に資産及び負債の額に大きな変動をもたらす事象は生じておらず、本吸収分割の効力発生日に至るまで、資産及び負債の額に大きな変動をもたらすその他の事象は生じない見込みであるため、上記6で記載した事項を考慮しても、甲においては、本吸収分割の効力発生日以後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれています。

また、本吸収分割の効力発生日以後において、甲が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。

以上を踏まえ、効力発生日以後における甲の債務の履行の見込みがあるものと判断いたしました。

- (2) 乙の債務（甲が本吸収分割により乙に承継させるものに限る。）の履行の見込みについて

乙の成立日（2022年12月5日）現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ1円及び0円です。

乙において、上記の日時時点から本書面作成日現在に至るまで、資産及び負債の額に大きな変動をもたらす事象は生じておらず、本吸収分割の効力発生日に至るまで、資産及び負債の額に大きな変動をもたらす事象は生じない見込みであり、また、本吸収分割により甲から乙へ承継される予定の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれるため、乙においては、本吸収分割の効力発生日以後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれています。

また、本吸収分割の効力発生日以後において、乙が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。

以上を踏まえ、効力発生日以後における乙の債務の履行の見込みがあるものと判断いたしました。

別紙 1

吸収分割契約書
(次頁以降に添付のとおり)



吸収分割契約書

三菱マテリアル株式会社（以下「甲」という。）と高純度シリコン株式会社（以下「乙」という。）は、甲が営む多結晶シリコン事業（以下「本事業」という。）に関して有する権利義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本分割」という。）について、以下のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（吸収分割）

甲は、本契約の定めに従い、本効力発生日（第6条に定義する。以下同じ。）をもって、本分割により、本事業に関して、承継対象権利義務（第3条第1項において定義する。）を乙に承継させ、乙はこれを承継する。

第2条（分割当事会社の商号及び住所）

本分割における吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、次のとおりとする。

① 甲（吸収分割会社）

商号：三菱マテリアル株式会社

住所：東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

② 乙（吸収分割承継会社）

商号：高純度シリコン株式会社

住所：三重県四日市市三田町5番地

第3条（承継する権利義務）

- 乙が本分割により甲から承継する資産、債務、契約その他の権利義務（以下「**承継対象権利義務**」という。）は、別紙「承継権利義務明細表」記載のとおりとする。
- 本分割による甲から乙に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。甲は、本分割の効力発生後に前項に基づき甲から乙に承継された債務について履行その他の負担をした場合、乙に対して、当該負担の全額について求償することができる。
- 乙は、本分割の効力発生後に第1項に基づき甲から乙に承継された債務以外の甲の債務（会社法第759条第3項に基づく請求による債務を含む。）について履行その他の負担をした場合、甲に対して、当該負担の全額について求償することができる。
- 乙は、いかなる場合も、甲から、別紙「承継権利義務明細表」に明示的に記載された承継対象権利義務以外の資産、債務（本事業に関する有利子負債、偶発債務、簿外債務等を含み、当該債務の原因事実の発生時期を問わない。）、契約その他の権利義務を一切承継せず、これについて何らの責任も負わない。
- 甲及び乙は、承継対象権利義務のうちその承継又は対抗要件具備のために登記、登録、

通知、承諾その他の手続を必要とするものにつき、相互に協力してこれを行うものとし、かかる手続の履行に関して乙に生ずる公租公課及び費用は、乙の負担とする。

第4条（本分割の対価）

乙は、本分割に際して、承継対象権利義務の対価として、乙の普通株式 1 株を発行し、甲に対し、その全てを交付する。

第5条（乙の資本金及び準備金の額）

本分割に際し、乙の資本金、資本準備金及び利益準備金の額は増加しないものとする。

第6条（本分割の効力発生日）

本分割が効力を生ずる日（以下「**本効力発生日**」という。）は、2023年3月31日とする。但し、本分割の手続上の必要性その他の事由（承継対象権利義務の移転について法令に定める関係官庁等の承認又は許認可等を要するものに関し、本効力発生日までに承認又は許認可等を得られないことが合理的に見込まれる場合を含む。）により必要な場合には、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができる。

第7条（本契約の承認手続）

1. 甲は、会社法第 784 条第 2 項の規定により、本契約に関する同法第 783 条第 1 項に定める株主総会の決議による承認を得ることなく本分割を行う。なお、会社法第 784 条第 2 項に定める分割会社の総資産額の算定基準日は、2022 年 12 月 31 日とする。
2. 乙は、本効力発生日の前日までに、本契約に関する同法 795 条第 1 項に定める株主総会の決議による承認を得た上で、本分割を行う。

第8条（競業禁止）

甲は、乙に承継する本事業について、会社法第 21 条に基づく競業禁止義務を負わない。

第9条（本契約の変更・解除）

甲及び乙は、本契約の締結後、本効力発生日に至るまでの間に、甲又は乙の財産その他の権利義務又は経営状況に重大な悪影響が生じたとき、その他本分割の実行に重大な支障となる事態が生じたときには、甲乙協議の上、合意により本契約に定める条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

第10条（本契約の効力）

本契約は、本分割に要する法令に定める関係官庁等の承認若しくは許認可等を得られな

かった場合、又は第9条の規定により本契約が解除された場合には、その効力を失う。

第11条 （準拠法）

本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。

第12条 （管轄）

甲及び乙は、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第13条 （誠実協議）

甲及び乙は、本契約の解釈に疑義のある事項又は本契約に規定のない事項については、本契約の趣旨に従い、誠実に協議の上決定する。

（条文以上）

以上の合意の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名又は記名押印の上、各1通を保有する。

2022年12月27日

甲（吸収分割会社）：

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

三菱マテリアル株式会社

代表執行役 小野 直樹



2022年12月27日

乙（吸収分割承継会社）：
三重県四日市市三田町5番地
高純度シリコン株式会社
代表取締役 太田 啓武



別紙

承継権利義務明細表

本効力発生日において、本分割によって乙が甲から承継する資産、債務、契約その他の権利義務は、本効力発生日の前日の終了時点（以下「本基準時」という。）において有効に存在する次に定める甲の権利義務（但し、承継につき法令による許認可又は第三者の同意若しくは承認等が必要な権利義務であって、本基準時までには、当該許認可又は同意若しくは承認等が得られないものを除く。）とする。

1. 資産（本事業のみに属するものに限る。）

(1) 流動資産

- ① 現金及び預金
- ② 売掛金
- ③ 棚卸資産
- ④ 前渡金
- ⑤ 前払費用
- ⑥ 未収入金
- ⑦ 仮払金

(2) 固定資産

- ① 有形固定資産（別添 1.(2)①記載の土地並びに建物及び構築物を含む。）
- ② 無形固定資産（別添 1.(2)②-1 記載の知的財産権並びに別添 1.(2)②-2 記載のソフトウェア及びITシステムを含む。また、特許権及び特許を受ける権利を含むが、別添 1.(2)②-3 記載の発明に係る特許権及び特許を受ける権利を除く。）
- ③ 差入保証金
- ④ 効力発生日において甲が保有する MITSUBISHI POLYCRYSTALLINE AMERICA CORPORATION 社の株式及び日本アエロジル株式会社の株式
- ⑤ 別添 1.(2)⑤記載の有価証券等

(3) 上記(1)及び(2)記載の資産のほか本事業のみに属する一切の資産

2. 債務（本事業のみに属するものに限る。なお、(i)公租公課に関する債務、(ii)本吸収分割により承継しない資産に関連する債務、並びに(iii)本事業に関する不法行為債務その他の偶発債務又は簿外債務（上記 1.に掲げる承継対象の資産、下記 3.に掲げる承継対象の契約及び下記 4.に掲げる承継対象の従業員に関する本効力発生日以前の事実に基づく偶発債務又は簿外債務を含む。）その他本項に掲げる債務以外の一切の債務は承継せず、乙はこれらを負担しない。）

(1) 流動負債

- ① 買掛金
- ② 未払金
- ③ 未払費用
- ④ 前受金
- ⑤ 預り金
- ⑥ リース債務（短期）

(2) 固定負債

- ① 本クロージング日（甲と株式会社 SUMCO との間の 2022 年 10 月 28 日付株式譲渡契約書に定義される。）付で甲から乙に転籍する甲の従業員に係る退職一時金に係る退職給付引当金
- ② リース債務（長期）

3. 契約

甲が本事業のみに関して締結している一切の契約（**別添 3.**記載の「承継対象外契約」及び雇用契約を除く。）に係る契約上の地位及びこれらの契約に基づく一切の権利義務（本効力発生日までに弁済期が到来した未払賃金債務その他第 2 項なお書きの債務を除く。）

4. 雇用契約

本事業に主として従事する甲の従業員であって、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第 4 条第 1 項に基づき甲に異議を申し出た者との間の労働契約及びこれらの契約に基づく一切の権利義務（未払賃金債務、未払賞与債務、退職給付債務その他の本効力発生日以前に生じた原因に基づく一切の金銭債権及び金銭債務を含むが（但し、本効力発生日後に弁済期が到来するものに限り、第 2 項なお書きの債務を除く。）、本効力発生日までに弁済期が到来した未払賃金債務その他第 2 項なお書きの債務を除く。）

5. 許認可等

甲が本事業のみに関して取得している免許、許可、認可、承認、登録、届出等（**別添 5.**記載の許認可等を含む。但し、法令上承継可能なものに限る。）

以 上

承継対象土地並びに建物及び構築物

1. 土地

No	所在及び地番	地目	地積 (㎡) [登記簿(全体)]	地積 (㎡) [当社持分]
1	三重県四日市市三田町4番4	雑種地(現況:宅地)	4768	4768
2	三重県四日市市三田町5番	宅地	20132.1	20132.1
3	三重県四日市市三田町2番	雑種地(現況:宅地)	92750	92750
4	三重県四日市市三田町6番	公衆用道路	9002	2626.58
5	三重県四日市市石原町1番8	公衆用道路	1934	564.3
6	三重県四日市市石原町1番9	公衆用道路	946	276.02
7	三重県四日市市石原町2番1	公衆用道路	1874	546.79
8	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5519番	雑種地(現況:宅地)	6168	6168
9	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5520番	雑種地(現況:宅地)	986	986
10	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5521番	雑種地(現況:宅地)	228	228
11	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5543番	雑種地(現況:宅地)	518	518
12	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5544番	雑種地(現況:宅地)	526	526
13	三重県鈴鹿市御菌町字桜台5545番	雑種地(現況:宅地)	2481	2481

2. 登記済建物

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
1	三田町2	第2プラント	2PL 厚生棟 1/2	46.2
2	三田町2	第2プラント	2PL 厚生棟 2/2	80.12
3	三田町5	第1プラント	消火栓用ポンプ室	23.02
4	三田町5	第1プラント	変電室	33.79
5	三田町5	第1プラント	4精	472.32
6	三田町5	第1プラント	2棟	394.14

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
7	三田町 5	第 1 プラント	2 棟 増築 1	269.7
8	三田町 5	第 1 プラント	2 棟 増築 2	276.8
9	三田町 5	第 1 プラント	2 棟 増築 3	181.79
10	三田町 5	第 1 プラント	分析棟	193
11	三田町 5	第 1 プラント	1 棟	912.96
12	三田町 5	第 1 プラント	1 棟 増築 1	726.88
13	三田町 5	第 1 プラント	1 棟 増築 2	880.81
14	三田町 5	第 1 プラント	塩素処理倉庫	88.27
15	三田町 5	第 1 プラント	1・5 精	386.63
16	三田町 5	第 1 プラント	1・5 精 増築	449.27
17	三田町 5	第 1 プラント	2 精製	454.47
18	三田町 5	第 1 プラント	3 精製	437.7
19	三田町 5	第 1 プラント	E 棟	995.08
20	三田町 5	第 1 プラント	F 棟	684.83
21	三田町 5	第 1 プラント	3 棟	123.98
22	三田町 5	第 1 プラント	3 棟 増築	84.44
23	三田町 5	第 1 プラント	第 1 塩化棟	954.95
24	三田町 5	第 1 プラント	第 1 塩化棟 増築	563.7

3.1 未登記建物 (四日市)

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
1	石原町 1-2	液製品倉庫	液製品倉庫 2	242
2	石原町 1-39	液製品倉庫	液製品倉庫事務所	53.57
3	石原町 1-39	液製品倉庫	消火用エンジンポンプ室	16.22
4	石原町 1-39	液製品倉庫	液製品倉庫 1	242
5	石原町 1-23	第 1 プラント	事務所厚生棟	416.56
6	石原町 1-27	第 1 プラント	事務所車庫	84.56
7	石原町 1-27	第 1 プラント	事務所喫煙室	8.8
8	石原町 1-27	第 1 プラント	新事務所	1327.53
9	石原町 1-39	液製品倉庫	プレハブ倉庫	147.8
10	三田町 2	第 2 プラント	第一反応棟	2893.48
11	三田町 2	第 2 プラント	第一転化炉棟	776.76

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
12	三田町 2	第 2 プラント	中央制御棟	1410.22
13	三田町 2	第 2 プラント	第 5 変電所	398
14	三田町 2	第 2 プラント	消火栓ポンプ室	40.62
15	三田町 2	第 2 プラント	計装コンプレッサー室	304.3
16	三田町 2	第 2 プラント	排水フィルタープレス室	205.5
17	三田町 2	第 2 プラント	第一転化フィルタープレス室	144.92
18	三田町 2	第 2 プラント	2P 守衛所	38.38
19	三田町 2	第 2 プラント	量水器盤室	6.91
20	三田町 2	第 2 プラント	計測器物置	1.87
21	三田町 2	第 2 プラント	給水栓消火ポンプ室	25.18
22	三田町 2	第 2 プラント	第 1 水素精製棟	853.26
23	三田町 2	第 2 プラント	機器整備場 倉庫	9.26
24	三田町 2	第 2 プラント	機器整備場監視室	9.95
25	三田町 2	第 2 プラント	開発評価室	48.96
26	三田町 2	第 2 プラント	開発評価室ボンベ倉庫	1.62
27	三田町 4	第 1 プラント	東事務所	354.24
28	三田町 4-1	第 1 プラント	第 6 精製凝縮系	563.5
29	三田町 4-1	第 1 プラント	酸洗場	157.33
30	三田町 5	第 1 プラント	フィルタープレス室	188.9
31	三田町 5	第 1 プラント	メタシリ倉庫	185.59
32	三田町 5	第 1 プラント	第 2 塩化棟	557.52
33	三田町 5	第 1 プラント	第 2 変電設備	120.73
34	三田町 5	第 1 プラント	G 棟	1368.54
35	三田町 5	第 1 プラント	第 6 精製水素精製系	247.07
36	三田町 5	第 1 プラント	1PL 守警所・便所	29.46
37	三田町 5	第 1 プラント	塩化電気室 3	143
38	三田町 5	第 1 プラント	第 3 粗蒸留棟	49.79
39	三田町 5	第 1 プラント	塩酸コンプレッサー室	29.4
40	三田町 5	第 1 プラント	給水栓消火ポンプ室	17.11
41	三田町 5	第 1 プラント	設備管理部物品倉庫	7.83
42	三田町 5	第 1 プラント	設備管理部物品倉庫	7.83
43	三田町 5	第 1 プラント	設備管理部物品倉庫	7.83

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
44	三田町 5	第 1 プラント	設備管理部物品倉庫	7.83
45	三田町 5	第 1 プラント	E 棟 増築	46.25
46	三田町 5	第 1 プラント	第 1 塩化棟 増築	33.21
47	三田町 5	第 1 プラント	第 1 塩化棟 増築	55.77
48	三田町 5	第 1 プラント	北事務所	212.7
49	三田町 5	第 1 プラント	第 1 塩化棟 増築	23.56
50	三田町 5	第 1 プラント	廃棄物置場	29.21
51	三田町 5	第 1 プラント	TCS 受入場	132.69
52	三田町 5	第 1 プラント	NO6 塩化炉建屋	127.04
53	三田町 5	第 1 プラント	4 精 塩酸吸収棟	54.56
54	三田町 5	第 1 プラント	4CS 出荷場	40.03
55	石原町 1-27	第 1 プラント	事務所自転車駐車場	14.64
56	三田町 5	第 1 プラント	第 2 駐輪場	48
57	三田町 5	第 1 プラント	30 馬力空調室	11
58	三田町 5	第 1 プラント	2CS 冷凍機小屋	13
59	三田町 5	第 1 プラント	G 棟駐輪場	11
60	三田町 5	第 1 プラント	2CS 充填場	26.26
61	三田町 5	第 1 プラント	原料棟	342
62	三田町 5	第 1 プラント	粗蒸留棟	245.7
63	三田町 5	第 1 プラント	原料蒸留棟	184.15
64	三田町 5	第 1 プラント	第 2 粗蒸留棟	556.85
65	三田町 5	第 1 プラント	第 4 精製吸収吸着系	454
66	三田町 5	第 1 プラント	旧 第 5 精製	147.75
67	三田町 5	第 1 プラント	2CS 蒸留設備	30.8
68	三田町 5	第 1 プラント	有価廃油置場	8
69	三田町 5	第 1 プラント	軽油置場	3
70	三田町 5	第 1 プラント	水素回収熱媒冷却器	4
71	三田町 5	第 1 プラント	東事務所北 ボンベ置場	7
72	三田町 5	第 1 プラント	受変電設備東側既製品物置	2.88
73	三田町 5	第 1 プラント	1 棟西側空塩素ボンベ置場	2.15
74	三田町 5	第 1 プラント	1 棟西側塩素ボンベ置場	6.46
75	三田町 5	第 1 プラント	第 1 用水西側ラック下発電機屋根	7

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
76	三田町 5	第 1 プラント	2 棟北東計装コンプレッサー室	2.24
77	三田町 5	第 1 プラント	2 棟北東ポンベ置場	1.04
78	三田町 5	第 1 プラント	E 棟南西ハロン消火設備小屋	0.86
79	三田町 5	第 1 プラント	E 棟北側オイル倉庫	0.86
80	三田町 5	第 1 プラント	E 棟北側ポンベ置場	4.53
81	三田町 5	第 1 プラント	中和設備電気盤下屋 1	2.2
82	三田町 5	第 1 プラント	中和設備電気盤下屋 2	2.04
83	三田町 5	第 1 プラント	4 精南側ポンベ置場	1.2
84	三田町 5	第 1 プラント	4CS 出荷場西側電気盤下屋	4
85	三田町 5	第 1 プラント	塩化ポリマー処理上部屋根	7.5
86	三田町 5	第 1 プラント	塩化環水槽東側電気盤下屋	6.3
87	三田町 5	第 1 プラント	2 精南側電気盤下屋	1.55
88	三田町 5	第 1 プラント	1 棟東側液化アルゴンポンベ置場	3.12
89	三田町 5	第 1 プラント	3 精東側プレハブ物置	2.86
90	三田町 2	第 2 プラント	第 1 中和棟	118.7
91	三田町 3	第 2 プラント	第 1 転化・水素コンプレッサー室	70
92	三田町 4	第 2 プラント	第 1 転化・塩酸コンプレッサー室	54.76
93	三田町 9	第 2 プラント	第 1 転化塩酸回収棟	94.9
94	三田町 10	第 2 プラント	第 1 蒸留塔	629.28
95	三田町 5	第 2 プラント	廃油置場	6
96	三田町 6	第 2 プラント	雨水調整用ポンベ置場	6
97	三田町 7	第 2 プラント	コンテナ 10 台	91
98	三田町 8	第 2 プラント	オイル倉庫	3

3.2 未登記建物 (鈴鹿)

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
1	御菌町 5519	鈴鹿分室	鈴鹿分室事務工場棟	1006.33
2	御菌町 5519	鈴鹿分室	排水処理建屋	37.98
3	御菌町 5519	鈴鹿分室	NOx 除害設備建屋	33.54
4	御菌町 5519	鈴鹿分室	鈴鹿分室事務工場棟 (増築 1)	1729
5	御菌町 5519	鈴鹿分室	鈴鹿分室事務工場棟 (増築 2)	779.52
6	御菌町 5519	鈴鹿分室	第 2・3 変電所	108.29
7	御菌町 5519	鈴鹿分室	真空ポンプ室 2	11.58

No	住所	分類	名称	概算床面積 (㎡)
8	御菌町 5519	鈴鹿分室	廃プラ処理室	26.91
9	御菌町 5519	鈴鹿分室	鈴鹿分室事務工場棟 (増築 3)	615.3
10	御菌町 5519	鈴鹿分室	COD 測定室	3.61
11	御菌町 5519	鈴鹿分室	制御室 (排水 3)	28.5
12	御菌町 5519	鈴鹿分室	NH3 ボンベ分析室制御盤室	40.5
13	御菌町 5519	鈴鹿分室	Si ロッド用倉庫	117.57
14	御菌町 5519	鈴鹿分室	厚生棟	602.73
15	御菌町 5519	鈴鹿分室	出荷場屋根増強工事 (下屋設置)	117.93
16	御菌町 5519	鈴鹿分室	排水 3 の一部	107.16
17	御菌町 5519	鈴鹿分室	真空ポンプ室 1	7
18	御菌町 5519	鈴鹿分室	コンプレッサー室 1	7
19	御菌町 5519	鈴鹿分室	コンプレッサー室 2	8.8
20	御菌町 5519	鈴鹿分室	純水設備上屋	5.6
21	石原町 1-39	液製品倉庫	液製品倉庫 喫煙室	3.3
22	石原町 1-39	液製品倉庫	液製品倉庫 N2 ボンベ庫	7.2

承継対象知的財産権

1.1 日本の特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
1	登録	トリクロロシラン製造装置	5160181
2	登録	トリクロロシラン製造方法	6283482
3	登録	多結晶シリコンの製造方法	4831285
4	登録	電極の短絡防止方法および短絡防止板	4905638
5	登録	シリコンシードおよびその製造方法	4941631
6	登録	粉体物乾燥装置	5071047
7	登録	多結晶シリコンロッドの製造方法	5012385
8	登録	多結晶シリコンロッドの製造方法	5012386
9	登録	多結晶シリコン製造装置	5205892
10	登録	多結晶シリコンの製造方法及び製造装置	5130882
11	登録	多結晶シリコン反応炉	5182608
12	登録	シリコン材料用洗浄籠	5194654
13	登録	籠収納用トレイ及び収納庫	4867863
14	登録	トリクロロシラン製造装置	5428145
15	登録	トリクロロシラン製造装置	5428146
16	登録	トリクロロシラン製造装置	5119856
17	登録	多結晶シリコンの製造装置	5262086
18	登録	水素分離回収方法および水素分離回収設備	5344113
19	登録	水素精製回収方法および水素精製回収設備	5344114
20	登録	多結晶シリコン製造装置	5083034
21	登録	多結晶シリコンの製造方法および多結晶シリコン製造設備	5435188
22	登録	多結晶シリコン製造装置	5040679
23	登録	多結晶シリコン製造装置	5266817
24	登録	多結晶シリコン製造方法及び製造装置	5309689
25	登録	多結晶シリコン製造装置	5375312
26	登録	多結晶シリコン製造方法及び製造装置	5321252
27	登録	ガイドシューター及びシリコン材料の梱包方法	5119984
28	登録	多結晶シリコン製造装置	5157807
29	登録	クリーンベンチ	4941415

No.	状況	発明の名称	登録番号
30	登録	トリクロロシラン製造装置及びトリクロロシラン製造方法	5359082
31	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置並びにトリクロロシラン製造方法	5343437
32	登録	トリクロロシラン製造用反応装置及びトリクロロシラン製造方法	5343493
33	登録	トリクロロシラン製造装置	5423418
34	登録	クロロシラン精製装置及び精製方法	5387267
35	登録	多結晶シリコン破砕用ハンマー	5359115
36	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	5239624
37	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び洗浄装置並びに多結晶シリコンの製造方法	5029539
38	登録	多結晶シリコン製造方法	5428303
39	登録	多結晶シリコン反応炉	5476693
40	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	5509578
41	登録	トリクロロシラン製造装置	5444745
42	登録	多結晶シリコンのシリコン芯棒組立体及びその製造方法、多結晶シリコン製造装置、多結晶シリコン製造方法	5309963
43	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	5311014
44	登録	単結晶シリコン製造装置	5157878
45	登録	反応炉洗浄装置	5218091
46	登録	ポリマー処理装置および処理方法	5716279
47	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	5621957
48	登録	クロロシランの精製装置及びクロロシラン製造方法	5396954
49	登録	多結晶シリコン反応炉	5428420
50	登録	多結晶シリコン製造装置	5481886
51	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	5604803
52	登録	シリコン表面の清浄化方法	5423388
53	登録	マイクロバブル濃縮装置及び生成装置並びにそれらの方法	5440151
54	登録	シリコン用梱包体及び梱包方法	5343619
55	登録	多結晶シリコン材料の製造方法	6217140
56	登録	多結晶シリコン製造装置	5444860
57	登録	多結晶シリコンロッドの切断方法および切断装置	4807534
58	登録	トリクロロシラン製造装置及び製造方法	5316290

No.	状況	発明の名称	登録番号
59	登録	トリクロロシラン製造装置及び製造方法	5316291
60	登録	クロロシラン液の収納容器及びこの収納容器用閉止蓋	5316302
61	登録	多結晶シリコン製造装置	5338574
62	登録	多結晶シリコン製造用カーボン部品の精製方法	5428692
63	登録	三塩化シランの精製方法	5429464
64	登録	多結晶シリコンの製造方法および製造装置	5321827
65	登録	多結晶シリコン洗浄装置及び洗浄方法	5617230
66	登録	トリクロロシラン製造装置及びトリクロロシラン製造方法	5327072
67	登録	多結晶シリコン不純物測定方法	5413242
68	登録	多結晶シリコンロッドのクラック発生方法及びクラック発生装置	5671862
69	登録	多結晶シリコンの洗浄装置	5434576
70	登録	多結晶シリコン製造方法及び製造装置	5633142
71	登録	多結晶シリコン製造装置	5423488
72	登録	多結晶シリコン製造装置	5434698
73	登録	多結晶シリコンの破碎装置	5531876
74	登録	不活性ガスを用いたベンディングシステムによるホウ素化合物量を低減した多結晶シリコンの製造装置および製造方法	5573852
75	登録	トリクロロシラン製造装置	5482265
76	登録	多結晶シリコン反応炉	5477145
77	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	5477115
78	登録	多結晶シリコン塊の洗浄装置	5494360
79	登録	シリコンシード製造装置及び製造方法	5516326
80	登録	多結晶シリコンロッド解体機および解体装置	5927808
81	登録	多結晶シリコン反応炉	5686074
82	登録	多結晶シリコン製造工程で発生する汚泥のセメント原料化処理方法及びセメント原料製造装置	5772576
83	登録	多結晶シリコン反応炉	5761099
84	登録	多結晶シリコン製造方法	5742617
85	登録	トリクロロシラン製造装置及び製造方法	5630412
86	登録	多結晶シリコン洗浄装置	5817424
87	登録	多結晶シリコン洗浄装置及び洗浄方法	5761096
88	登録	可燃性を有する流体を取り扱う設備の着火防止構造	5915315

No.	状況	発明の名称	登録番号
89	登録	多結晶シリコン洗浄方法及び多結晶シリコン洗浄装置	6175909
90	登録	シリコン破砕片の真空乾燥方法	6273840
91	登録	粉体物乾燥装置	5360268
92	登録	トリクロロシラン製造装置及び製造方法	5900224
93	登録	多結晶シリコン製造用シードの製造方法	5974887
94	登録	多結晶シリコン反応炉	5648704
95	登録	多結晶シリコンロッド	6179220
96	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	5644890
97	登録	クロロシラン類製造装置及びクロロシラン類製造方法	6090018
98	登録	多結晶シリコン製造方法及び製造装置	6179246
99	登録	球状シリコンの製造方法	6149623
100	登録	トリクロロシラン製造方法	5754499
101	登録	多結晶シリコン塊の洗浄方法	5716816
102	登録	多結晶シリコン洗浄方法	5742925
103	登録	多結晶シリコン反応炉及び多結晶シリコン製造方法	5854113
104	登録	反応炉洗浄装置及び反応炉洗浄方法	6424776
105	登録	多結晶シリコン反応炉	6772753
106	登録	多結晶シリコン反応炉	6582883
107	登録	多結晶シリコン反応炉	6004076
108	登録	梱包箱及び梱包方法並びに取出方法	7004492
109	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	6819203
110	登録	シリコン破砕片の真空乾燥方法	6850982
111	登録	水素混合ガスの製造方法	6822285
112	登録	クロロシラン類の回収方法及びクロロシラン類回収装置	6897342
113	登録	多結晶シリコンロッド	6447676
114	登録	シリコン用包装袋、シリコン包装体、シリコン用梱包箱及びシリコンの梱包方法	6891724
115	登録	シリコン破砕片の表面清浄化方法	6928262
116	登録	多結晶シリコンロッド製造用反応炉及びその製造方法並びにそれを用いた多結晶シリコンロッドの製造方法	7020076
117	登録	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	6763428
118	登録	多結晶シリコンロッドの製造方法	7047688

No.	状況	発明の名称	登録番号
119	登録	半導体原料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体原料塊の製造方法	7074192
120	公開	高純度トリクロロシランの精製方法	2021- 100902 (公開番号)
121	審査 請求	低炭素高純度多結晶シリコン塊とその製造方法	2020- 164347 (公開番号)
122	審査 請求	シリコン用包装袋、シリコン包装体及びシリコンの包装方法	2019- 151406 (公開番号)
123	審査 請求	高純度多結晶シリコンの製造方法	2020- 164348 (公開番号)
124	審査 請求	トリクロロシランの製造方法	2021- 006492 (公開番号)
125	公開	半導体材料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体材料塊の製造方法	2021- 107042 (公開番号)
126	公開	多結晶シリコン製造用シードの製造方法及び切断加工治具	2021- 172563 (公開番号)
127	登録	クロロシラン及びその精製方法	3892794
128	登録	クロロシラン類の製造方法及び製造装置	6008385
129	登録	多結晶シリコンの包装方法、多結晶シリコンの二重包装方法及び単結晶シリコン用原料製造方法	7131608
130	公開	半導体材料塊の分級・洗浄方法	2022- 007574 (公開番号)
131	公開	トリクロロシランの製造方法	2022- 056490 (公開番号)

No.	状況	発明の名称	登録番号
132	公開	多結晶シリコン塊のクリーニング方法	2021-155323 (公開番号)
133	出願	多結晶シリコン製造用電極	2021-089737 (出願番号)
134	出願	カットロッドの包装体	2021-105615 (出願番号)
135	出願	リチャージ用多結晶シリコン塊	2021-121213 (出願番号)
136	出願	クロロシラン液輸送容器の洗浄方法	2021-173138 (出願番号)
137	登録	クロロシラン重合物の分解方法および分解装置	5321314
138	登録	トリクロロシランの製造装置	5633160
139	登録	多結晶シリコンロッド	5633174
140	登録	多結晶シリコンの製造方法及び製造装置	5633219
141	登録	多結晶シリコンの製造方法、製造装置及び多結晶シリコン	5655429
142	登録	多結晶シリコン破砕物の製造方法および多結晶シリコンの破砕装置	5637063
143	登録	多結晶シリコン製造装置	5648575
144	登録	多結晶シリコン還元炉	5360147
145	登録	多結晶シリコン破砕物の製造方法	5817185
146	登録	破砕装置及び破砕物製造方法	5853580
147	登録	クロロシラン重合物の分解方法	5818012
148	公開	多結晶シリコン塊表面の金属不純物分析方法	2020-186948 (公開番号)
149	登録	半導体材料用シリコンの洗浄方法とその多結晶シリコン塊、および洗浄装置	5071611
150	登録	多結晶シリコン製造用シードの製造装置	5249060
151	登録	ホウ素化合物の不純物を減じたトリクロロシラン製造方法	5657493

No.	状況	発明の名称	登録番号
152	登録	圧力スイング吸着処理による精製水素ガスの製造装置および方法	5824318
153	登録	半導体材料用シリコンの多結晶シリコン塊	5427330

2.1 米国の特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
154	登録	トリクロロシラン製造装置	8221691
155	登録	トリクロロシラン製造装置	7998428
156	登録	トリクロロシラン製造装置	9416014
157	登録	トリクロロシラン製造装置	9493359
158	登録	トリクロロシラン製造装置	7964155
159	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン製造設備	8017099
160	登録	トリクロロシラン製造装置	8034300
161	登録	トリクロロシラン製造用反応装置	8226895
162	登録	トリクロロシラン製造用反応装置	8557211
163	登録	トリクロロシラン製造装置	7641872
164	登録	トリクロロシラン製造装置	8367029
165	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置	8486339
166	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置	8974760
167	登録	反応炉洗浄装置	7975709
168	登録	反応炉洗浄装置	9216444
169	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	8329132
170	登録	多結晶シリコン反応炉	8231724
171	登録	多結晶シリコン反応炉	8790429
172	登録	多結晶シリコン反応炉	8703248
173	登録	多結晶シリコンのシリコン芯棒組立体及びその製造方法	9090962
174	登録	ハンマー	7950308
175	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	9988188
176	登録	クリーンベンチ	7976599
177	登録	クリーンベンチ	8372372

No.	状況	発明の名称	登録番号
178	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	9533279
179	登録	クロロシランの精製装置	8101131
180	登録	多結晶シリコン製造方法	8043660
181	登録	単結晶シリコン製造装置	8313577
182	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	8197783
183	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	7875349
184	登録	多結晶シリコン製造装置	8187382
185	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	8551439
186	登録	多結晶シリコン洗浄装置	7905963
187	登録	多結晶シリコン洗浄装置	8875720
188	登録	多結晶シリコン製造装置	8623139
189	登録	クロロシラン類の分析装置および分析方法	8158072
190	登録	クロロシラン液の収納容器	8297304
191	登録	トリクロロシラン製造装置	8252241
192	登録	トリクロロシラン製造装置	9724665
193	登録	トリクロロシラン製造装置	8187552
194	登録	トリクロロシラン製造装置	8529844
195	登録	トリクロロシラン製造装置	8187551
196	登録	トリクロロシラン製造装置	8980191
197	登録	多結晶シリコン製造装置	8652256
198	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び洗浄装置並びに多結晶シリコンの製造方法	9238876
199	登録	多結晶シリコン製造装置	8840723
200	登録	多結晶シリコン反応炉	8540818
201	登録	多結晶シリコン材料塊の洗浄装置および洗浄方法	8887744
202	登録	多結晶シリコン材料塊の洗浄装置および洗浄方法	9421583
203	登録	シリコンシート製造装置及び製造方法	8444800
204	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	8490901
205	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	9297586
206	登録	トリクロロシラン製造方法	8828345
207	登録	多結晶シリコン	9074299
208	登録	梱包箱及び梱包方法並びに取出方法	10384826
209	登録	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	11306001

No.	状況	発明の名称	登録番号
210	出願	半導体原料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体原料塊の製造方法	2021/026994 2 (公開番号)
211	公開	多結晶シリコンの包装方法、多結晶シリコンの二重包装方法及び単結晶シリコン用原料製造方法	2021/007048 4 (公開番号)
212	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	8507051
213	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	8551580
214	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	9169560
215	登録	多結晶シリコン製造装置	9315895
216	登録	Silicon cleaning method for semiconductor materials and polycrystalline silicon chunk	7223303
217	登録	Apparatus for manufacturing seeds for polycrystalline silicon manufacture	8425279
218	登録	Apparatus and method for producing polycrystalline silicon having a reduced amount of boron compounds by forming phosphorus-boron compounds	8404205
219	登録	Apparatus and method for producing polycrystalline silicon having a reduced amount of boron compounds by venting the system with an inert gas	8226920
220	登録	Apparatus and method for producing polycrystalline silicon having a reduced amount of boron compounds by venting the system with an inert gas	8518352
221	登録	Apparatus and method for producing purified hydrogen gas by a pressure swing adsorption processes	8241401
222	登録	Apparatus and method for producing purified hydrogen gas by a pressure swing adsorption processes	8431082
223	登録	Fluidized bed reactor heater	8945474
224	登録	Mechanical seed coupling	9863453
225	出願	Mechanical seed coupling	15/826.864 (出願番号)
226	登録	FZ seed holder and pre-heater	9410263
227	出願	Boron reduction in primary distillation	15/872.309 (出願番号)

No.	状況	発明の名称	登録番号
228	登録	Bubble size minimizing internals for fluidized bed reactors	2016/015248 2 (公開番号)
229	登録	Controlled silicon polymer treatment method	11261096
230	登録	Method to prevent grounding from a silicon rod to a plate in poly-silicon reactor	10512954
231	公開	Controlled hydrolysis of hazardous silicon polymer residue	2022/010547 7 (公開番号)
232	公開	Iron catalyzed hydrochlorination of silicon tetrachloride to trichlorosilane	2021/291133 (公開番号)

3.1 中国の特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
233	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200780042921.2
234	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200780027354.3
235	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200780012696.8
236	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200780012705.3
237	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200780012715.7
238	登録	トリクロロシラン製造用反応装置	ZL200810173001.0
239	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200810170083.3
240	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置	ZL201410434126.X
241	登録	反応炉洗浄装置	ZL200910002794.4

No.	状況	発明の名称	登録番号
242	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	ZL200810178738.1
243	登録	多結晶シリコン反応炉	ZL200810215096.8
244	登録	多結晶シリコン反応炉	ZL200910127656.9
245	登録	多結晶シリコンのシリコン芯棒組立体及びその製造方法	ZL200810189524.4
246	登録	ハンマー	ZL200810146324.0
247	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	ZL200810146329.3
248	登録	クリーンベンチ	ZL201310248647.1
249	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	ZL200910008332.3
250	登録	クロロシランの精製装置	ZL200910126859.6
251	登録	多結晶シリコン製造方法	ZL200810181949.0
252	登録	単結晶シリコン製造装置	ZL200810184947.7
253	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	ZL200810178687.2
254	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	ZL200910127948.2
255	登録	多結晶シリコン製造装置	ZL200910127763.1
256	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	ZL200910174675.7
257	登録	多結晶シリコン洗浄装置	ZL200910252918.4
258	登録	多結晶シリコン製造装置	ZL200910150342.0

No.	状況	発明の名称	登録番号
259	登録	クロロシラン液の収納容器	ZL200910167402.X
260	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL200910163836.2
261	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL201310302831.X
262	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び洗浄装置並びに多結晶シリコンの製造方法	ZL200980152264.6
263	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	ZL201010239811.9
264	拒絶 対応済	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	201780030859.9 (出願番号)
265	拒絶 対応済	半導体原料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体原料塊の製造方法	112334232 (公開番号)
266	登録	多結晶シリコンの包装方法、多結晶シリコンの二重包装方法及び単結晶シリコン用原料製造方法	ZL201980026289.5
267	登録	トリクロロシランの製造装置および製造方法	ZL201010136864.8
268	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	ZL201010229761.6
269	登録	破碎装置及び破碎物製造方法	ZL201210374457.X

3.2 中国の実用新案

No.	状況	発明の名称	登録番号
270	登録	破碎装置及び破碎物製造方法	ZL201220504285.9

4.1 イタリアの特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
271	登録	トリクロロシラン製造装置	2055674
272	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	2354090
273	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	502019000003034
274	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	2067745
275	登録	トリクロロシラン製造装置	502020000000457
276	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	502020000082090

5.1 ドイツの特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
277	登録	トリクロロシラン製造装置	602007042699
278	登録	トリクロロシラン製造装置	2000434
279	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン製造設備	2070871
280	登録	トリクロロシラン製造用反応装置	2052774
281	登録	トリクロロシラン製造装置	2055674
282	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置	2055375
283	登録	反応炉洗浄装置	602009001115
284	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	2077252
285	登録	多結晶シリコン反応炉	2039653
286	登録	多結晶シリコン反応炉	602009001587
287	登録	多結晶シリコンのシリコン芯棒組立体及びその製造方法	2075233
288	登録	ハンマー	2030737
289	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	2030905
290	登録	クリーンベンチ	2036856
291	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	2354090
292	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	602009055071
293	登録	クロロシランの精製装置	602009022344
294	登録	多結晶シリコン製造方法	2067744
295	登録	単結晶シリコン製造装置	2075357
296	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	2067745
297	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	2105409

No.	状況	発明の名称	登録番号
298	登録	多結晶シリコン製造装置	2105408
299	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	602009021536
300	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	602009033104
301	登録	多結晶シリコン洗浄装置	2192086
302	登録	多結晶シリコン製造装置	2138459
303	登録	クロロシラン液の収納容器	602009001160
304	登録	トリクロロシラン製造装置	602010062008
305	登録	トリクロロシラン製造装置	2151416
306	登録	多結晶シリコン製造装置	2161241
307	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び洗浄装置並びに多結晶シリコンの製造方法	2381017
308	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	2280097
309	登録	トリクロロシラン製造方法	2540666
310	登録	多結晶シリコン	2679541
311	登録	トリクロロシランの製造装置および製造方法	2233436
312	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	602010064564. 9
313	拒絶理由	多結晶シリコン破碎物の製造方法	102012102928 (公開番号)
314	拒絶理由	破碎装置及び破碎物製造方法	102012218822 (公開番号)

6.1 マレーシアの特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
315	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	146774
316	登録	多結晶シリコン洗浄装置	156449
317	登録	トリクロロシラン製造装置	176065
318	登録	トリクロロシラン製造装置	172498
319	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	155554
320	出願	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	2018002777 (出願番号)

7.1 台湾の特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
321	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン製造設備	436946
322	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	404659
323	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び多結晶シリコンの洗浄装置	523702
324	登録	梱包箱及び梱包方法並びに取出方法	680920
325	公開	半導体原料のクラック発生方法及び半導体原料塊の製造方法	202005716 (公開番号)

8.1 韓国の特許

No.	状況	発明の名称	登録番号
326	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン製造設備	1426099
327	登録	トリクロロシラン製造用反応装置	1479344
328	登録	トリクロロシラン製造装置	1528369
329	登録	塩化水素ガス噴出用部材及びトリクロロシラン製造用反応装置	1537409
330	登録	反応炉洗浄装置	1477817
331	登録	多結晶シリコン製造装置及び製造方法	1488533
332	登録	多結晶シリコン反応炉	1811872
333	登録	多結晶シリコン反応炉	1577452
334	登録	多結晶シリコンのシリコン芯棒組立体及びその製造方法	1529732
335	登録	ハンマー	1456715
336	登録	シリコンの梱包方法及び梱包体	1538167
337	登録	クリーンベンチ	1424288
338	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び多結晶シリコンの洗浄装置	1494462
339	登録	トリクロロシランの製造方法および製造装置	1573933
340	登録	クロロシランの精製装置	1577454
341	登録	多結晶シリコン製造方法	1529730
342	登録	単結晶シリコン製造装置	1485188
343	登録	転換反応ガスの分離回収方法。	1538168
344	登録	多結晶シリコン製造装置におけるポリマー不活性化方法	1577823
345	登録	多結晶シリコン製造装置	1564782
346	登録	半導体シリコン製造用カーボン部品の精製方法	1632441

No.	状況	発明の名称	登録番号
347	登録	多結晶シリコン洗浄装置	1670084
348	登録	多結晶シリコン製造装置	1620635
349	登録	クロロシラン液の収納容器	1544618
350	登録	トリクロロシラン製造装置	1687833
351	登録	トリクロロシラン製造装置	1614542
352	登録	多結晶シリコンの洗浄方法及び洗浄装置並びに多結晶シリコンの製造方法	1332922
353	登録	多結晶シリコンロッドの破碎方法及び破碎装置	1702657
354	登録	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	2303581
355	公開	半導体原料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体原料塊の製造方法	2021-0027357 (公開番号)
356	公開	多結晶シリコンの包装方法、多結晶シリコンの二重包装方法及び単結晶シリコン用原料製造方法	2020-0144105 (公開番号)
357	登録	多結晶シリコンの製造方法及び多結晶シリコン	1708058

9.1 EPC 出願特許

No.	状況	発明の名称	出願番号
358	拒絶理由	多結晶シリコンロッド及びその製造方法	17815420.9
359	審査請求	半導体原料の破碎方法又はクラック発生方法、及び半導体原料塊の製造方法	19830553.4
360	審査請求	多結晶シリコンの包装方法、多結晶シリコンの二重包装方法及び単結晶シリコン用原料製造方法	19789357.1

承継対象ソフトウェア及びITシステム

1. ソフトウェア

N o.	ソフトウェア名称	バージョン	ライセンス数
1	マイクロソフト Office2016 Professional	2016Pro	50
2	ASPEN	V10	同時接続 40
3	SPC システム	-	30
4	232 データロガー with Mail	-	1
5	A HotDocument for Visual Basic 2005		1
6	Arcserve Replication r16.5 for Windows Virtual Machine	r16.5	4
7	Antenna House リッチテキスト PDF3		2
8	AutoCAD LT 更新 Single-user 1 年契約	-	14
9	B' s Recorder 16	16	1
10	CD-ROM 『TPM カットカット素材事典』	-	1
11	CLEAR-DA RAID 10 ライセンス	-	10
12	Corel VideoStudio Pro X8 通常版	X8	2
13	ATOK 2006 for Windows	2006	1
14	ATOK 2007 for Windows	2007	1
15	ATOK2008 for Window	2008	1
16	DAQSTANDARD DXA120 for DXAdvanced	-	5
17	EnterpriseArchitect	-	2
18	Excel による多成分系蒸留計算プログラム	-	1
19	GKitOCX Spreadsheet V5	5	4
20	GP-ProEX Ver4.0	4	1
21	GX DEVELOPER VERSION8	8	10
22	GX Works3(日本語版)	3	<サイトライセンス>
23	GX Works3(日本語版)	3	1
24	iSpring Converter Pro 8	8	1
25	JacConvert Ver2.94	2.94	5
26	Visio Standard 2016	2016	2
27	Oracle Database Standard Edition	-	30
28	PDFelement Pro 7 永久ライセンス	7	4

N o.	ソフトウェア名称	バージョン	ライセンス数
29	PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows Linux(非仮想化環境)	-	1
30	Smart-UPS 500/750 用 PowerChute Business Edition Deluxe for Windows	-	1
31	SQL Server Per User Client Access License Japanese 2017	2017	5
32	SQL Server Standard per Core 2 Licenses Software License Japanese 2017	2017	8
33	Systemwalker Live Help Expert	V15	4
34	Visio Professional 2019	2019	1
35	Visual Basic Ver6	6	2
36	Visual Studio Pro 2008	2008	3
37	Visual Studio Professional Per User Software License Japanese(2017)	2017	1
38	VT3-H3 VT3 作画ソフト VT STUDIO Ver.4	4	1
39	Windows 10 Pro 日本語版	10	8
40	Windows 7 Professional SP1	7	6
41	Windows7AnytimeUpgradeHomePremiumtoProfessional	7	1
42	Windows 8 Professional Upgrade	8	2
43	Windows 8.1 Professional Upgrade	8.1	1
44	Windows Server Per User Client Access License Japanese(2019)	2019	50
45	Windows Server Per User Client Access License Japanese(2012)	2012	200
46	Windows Server Standard per Core 16 Licenses Software License Japanese	2019	11
47	まとめて瞬間 PDF	-	2
48	ボイスソムリエ ネオ(ベーシックモデル)女性 1	-	2
49	ディスクシュレッダー2・スタンダード CD-ROM	2	2
50	ドキュメント自動生成ツール for Visual Basic6.0	-	1
51	特打式 Office Pack Office2013 対応版	2013	1
52	特打式 OfficePack Office2016 対応版	2016	3
53	秘文 Data Encryption	-	2
54	MX Sheet	-	2

No.	ソフトウェア名称	バージョン	ライセンス数
55	MX Component	-	4
56	MVTec HALCON 20.11 Progress	-	1
57	Any Video Converter Pro	-	9
58	FD-G Monitor	-	1
59	GP-Viewer	-	1
60	筆王	-	1
61	ShutterLessViewer	-	1
62	ActiveImageProetctor	-	2
63	BT-H51W	-	1
64	The 翻訳オフィス V10	V10	2
65	XPS7L	-	1
66	FLEXSCHE17.0.06012 (64bit)	17	1
67	MVTec HALCON 20.11 Progress	20.11	1
68	Fuji Xerox DocuWorks 9	-	7
69	CipherCraft/Mail 7	-	9

2. 主要システム

No.	システム名称
1	PSI システム
2	液ポンベ管理システム
3	バルクシステム
4	分析データ管理システム
5	ASPEN
6	SPC システム
7	製造情報
8	教育訓練管理システム
9	iReporter
10	事故報告
11	ヒヤリ B システム
12	改善提案
13	産廃システム
14	物品管理システム

No.	システム名称
15	反応炉組システム

承継対象外知的財産権

No.	状況	発明の名称	登録番号
1	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシラン製造装置	5601438
2	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	5488777
3	登録	トリクロロシラン製造装置	5012449
4	登録	トリクロロシランの製造方法および利用方法	5333725
5	登録	トリクロロシランの製造方法と製造装置および多結晶シリコンの製造方法	5397580
6	登録	トリクロロシランの製造方法および用途	5392488
7	登録	トリクロロシラン製造装置	5633375
8	登録	トリクロロシラン製造装置および製造方法	5482687
9	登録	トリクロロシラン製造装置及び製造方法	5637013
10	登録	トリクロロシラン製造装置	5637018
11	登録	トリクロロシラン製造装置	5494534
12	登録	トリクロロシラン製造装置	5708332
13	登録	トリクロロシラン製造装置	5974857
14	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	9994455
15	登録	トリクロロシランの製造方法および利用方法	8168152
16	登録	トリクロロシラン製造装置	8663573
17	登録	トリクロロシラン製造装置	8809746
18	登録	トリクロロシラン製造装置	9468042
19	登録	トリクロロシラン製造装置	8372346
20	登録	トリクロロシラン製造装置	9168502
21	登録	多結晶シリコンの破碎装置及び多結晶シリコン破碎物の製造方法	8439287
22	登録	多結晶シリコンの破碎装置及び多結晶シリコン破碎物の製造方法	8434707
23	登録	多結晶シリコン破碎物の製造方法	8944353
24	登録	破碎装置及び破碎物製造方法	8955781
25	登録	破碎装置及び破碎物製造方法	8955780

No.	状況	発明の名称	登録番号
26	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	ZL2007800 24594.8
27	登録	トリクロロシランの製造方法および利用方法	ZL2009801 43120.4
28	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2011100 41339.2
29	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2014104 03740.X
30	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2011100 20020.1
31	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2011100 49613.0
32	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2011100 52378.2
33	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2011100 58697.4
34	登録	トリクロロシラン製造装置	ZL2012104 95009.5
35	登録	多結晶シリコンの破碎装置及び多結晶シリコン破碎物の製造方法	ZL2011103 24815.1
36	登録	多結晶シリコンの破碎装置及び多結晶シリコン破碎物の製造方法	ZL2011103 32091.5
37	登録	破碎装置及び破碎物製造方法	ZL2012103 69255.6
38	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	5020180000 33379
39	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	2154110
40	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	2085359
41	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	2088124
42	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	2154110
43	登録	トリクロロシラン製造装置	6020110051 42.3

No.	状況	発明の名称	登録番号
44	登録	トリクロロシラン製造装置	6020110066 68.4
45	登録	トリクロロシラン製造装置	6020110100 49.1
46	拒絶理由	多結晶シリコンの破砕装置及び多結晶シリコン破砕物の製造方法	1020110849 37 (公開番号)
47	登録	多結晶シリコンの破砕装置及び多結晶シリコン破砕物の製造方法	1020110849 38
48	登録	多結晶シリコンの破砕装置及び多結晶シリコン破砕物の製造方法	1020110849 39
49	審査請求	破砕装置及び破砕物製造方法	1020122188 20 (公開番号)
50	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	448429
51	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	430947
52	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	434805
53	登録	トリクロロシランの製造方法及びトリクロロシラン製造装置	1388323
54	登録	トリクロロシランの製造方法およびトリクロロシランの製造装置	1400481

承継対象有価証券等

No.	内容	帳簿価額 (円)
1	名四カントリークラブ 保証金預託証書	500,000
2	三鈴カントリー倶楽部 預託金証書	1,800,000
3	希望荘 出資証券	50,000
4	財団法人三重県環境保全事業団 契約保証金供託残高証明書	6,000,000
5	中電不動産株式会社三重支社 保証金	1,001,000
6	有限会社名阪サービス 敷金預かり証	6,840,000
7	太平洋建設株式会社 敷金預かり証	1,485,000
8	篠田牧子 敷金預かり証	170,000

別添3.

承継対象外契約

売主及び Vishay 社（旧・General Semiconductor 社）の間の 2000 年 8 月付 Guaranty Agreement

承継対象許認可等

No.	許認可等	根拠法令
1.	製造所設置許可	消防法第 11 条第 1 項
2.	第一種事業者	石油コンビナート等災害防止法第 5 条第 1 項
3.	第一種製造者	高压ガス保安法第 5 条第 1 項
4.	保管事業者	ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関する特別阻止法第 8 条第 1 項
5.	特定工場	工場立地法第 6 条第 1 項
6.	特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る届出	水質汚濁法第 5 条第 3 項
7.	産業廃棄物処理施設設置者	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条第 1 項
8.	指定施設設置者	三重県生活環境の保全に関する条例第 23 条第 1 項

別紙 2

吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表

(2022年12月5日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【1】	負債の部計	0
現金及び預金	1	純資産の部	
		【株主資本】	【1】
		資本金	1
		純資産の部計	1
資産の部合計	1	負債・純資産の部合計	1

別紙 3

吸収分割株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容

1. 甲及び UBE 株式会社が折半出資する UBE 三菱セメント株式会社（甲の持分法適用関連会社、以下「MUCC 社」といいます。）は、2022 年 9 月 26 日開催の同社取締役会において、事業構造改革の一環として、2023 年 3 月末を目途に、同社青森工場の操業停止及び同社伊佐セメント工場の生産縮小（1 号キルンの停止）による生産体制の見直し（以下「本施策」）について決議いたしました。本施策による損失（特別損失）について、現時点で MUCC 社は、2023 年 3 月期及び翌期以降に 200 億円程度を見込んでおります。なお、これらは、概算見積もりに基づく金額であり、現在精査中のため、今後変更となる可能性があります。
甲においては、MUCC 社における特別損失計上額の出資比率（50%）相当の金額を、持分法による投資損失（営業外損失）として計上する見込みです。
以上もふまえ、2023 年 3 月期の甲の連結決算において、MUCC 社に係る持分法による投資損失約 264 億円を営業外費用として計上する見込みです。
2. 甲は、2022 年 10 月 28 日開催の取締役会において、本吸収分割を実行のうえ、乙の全株式を株式会社 SUMCO に譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。）を決議いたしました。本株式譲渡に伴い、米国三菱ポリシリコン社は甲の特定子会社ではなくなります。
また、2023 年 3 月期第 4 四半期までの個別決算において、事業再編損失として約 350 億円の特別損失を計上する見込みです。

以上